

在大陸地區從事投資或技術合作禁止類製造業產品項目部分項目修正對照表

修正表列				現行表列				說 明
C. C. C. Code		類別	產 品 項 目 名 稱	C. C. C. Code		類別	產 品 項 目 名 稱	
8542320011	EX	禁止類	光罩式唯讀記憶體晶片之單石數位積體電路晶粒及晶圓(超過 <u>十二</u> 吋晶圓鑄造)	8542320011	EX	禁止類	光罩式唯讀記憶體晶片之單石數位積體電路晶粒及晶圓(超過八吋晶圓鑄造, <u>但併購、參股投資者除外</u>)	鑑於大陸地區半導體產業正快速成長, 國際領導大廠更與大陸地區晶圓廠技術合作, 而我國目前除併購、參股投資者外, 僅開放赴大陸地區鑄造八吋廠晶圓廠, 為確保我國晶圓鑄造廠產業「技術領先、投資優先」之優勢地位, 以貼近市場與國際對手競爭, 爰放寬限制將原「超過八吋晶圓鑄造, 但併購、參股投資者除外」, 修正為「超過十二吋晶圓鑄造」。
8542320013	EX	禁止類	光罩式唯讀記憶體晶片之單石積體電路晶粒及晶圓(超過 <u>十二</u> 吋晶圓鑄造)	8542320013	EX	禁止類	光罩式唯讀記憶體晶片之單石積體電路晶粒及晶圓(超過八吋晶圓鑄造, <u>但併購、參股投資者除外</u>)	同上
8542320015	EX	禁止類	光罩式唯讀記憶體晶片之混合積體電路晶粒及晶圓(超過 <u>十二</u> 吋晶圓鑄造)	8542320015	EX	禁止類	光罩式唯讀記憶體晶片之混合積體電路晶粒及晶圓(超過八吋晶圓鑄造, <u>但併購、參股投資者除外</u>)	同上
8542320021	EX	禁止類	動態隨機存取記憶體積體電路晶粒(超過 <u>十二</u> 吋晶圓鑄造)	8542320021	EX	禁止類	動態隨機存取記憶體積體電路晶粒(超過八吋晶圓鑄造, <u>但併購、參股投資者除外</u>)	同上

8542320022	EX	禁止類	動態隨機存取記憶體積體電路晶圓(超過 <u>十二</u> 吋晶圓鑄造)	8542320022	EX	禁止類	動態隨機存取記憶體積體電路晶圓(超過八吋晶圓鑄造， <u>但併購、參股投資者除外</u>)	同上
8542320031	EX	禁止類	靜態隨機存取記憶體積體電路晶粒(超過 <u>十二</u> 吋晶圓鑄造)	8542320031	EX	禁止類	靜態隨機存取記憶體積體電路晶粒(超過八吋晶圓鑄造， <u>但併購、參股投資者除外</u>)	同上
8542320032	EX	禁止類	靜態隨機存取記憶體積體電路晶圓(超過 <u>十二</u> 吋晶圓鑄造)	8542320032	EX	禁止類	靜態隨機存取記憶體積體電路晶圓(超過八吋晶圓鑄造， <u>但併購、參股投資者除外</u>)	同上
8542390011	EX	禁止類	其他單石數位積體電路晶粒(超過 <u>十二</u> 吋晶圓鑄造)	8542390011	EX	禁止類	其他單石數位積體電路晶粒(超過八吋晶圓鑄造， <u>但併購、參股投資者除外</u>)	同上
8542390012	EX	禁止類	其他單石數位積體電路晶圓(超過 <u>十二</u> 吋晶圓鑄造)	8542390012	EX	禁止類	其他單石數位積體電路晶圓(超過八吋晶圓鑄造， <u>但併購、參股投資者除外</u>)	同上
8542390021	EX	禁止類	其他混合積體電路晶粒及晶圓(超過 <u>十二</u> 吋晶圓鑄造)	8542390021	EX	禁止類	其他混合積體電路晶粒及晶圓(超過八吋晶圓鑄造， <u>但併購、參股投資者除外</u>)	同上

修正備註	現行備註	說明
<p>一、製造業未列禁止類之 8542320011、8542320013、8542320015、8542320021、8542320022、8542320031、8542320032、8542390011、8542390012 及 8542390021 等十項，其受理審查原則如下：</p> <p>(一) <u>赴大陸投資新設晶圓鑄造廠或併購、參股大陸晶圓鑄造廠，不得為超過十二吋晶圓鑄造。新設晶圓鑄造廠採總量管制原則，以核准投資十二吋廠三座為上限，併購、參股投資大陸晶圓鑄造廠，則無數量限制。</u></p> <p>(二) <u>投資之製程技術須落後該公司在臺灣之製程技術一個世代以上。</u></p> <p>(三) <u>申請人應為臺灣之晶圓鑄造公司。</u></p> <p>(四) <u>申請人以新設或併購方式投資應有主控權。</u></p> <p>(五) <u>臺灣應有相對投資及研發。</u></p> <p>(六) <u>大陸晶圓鑄造廠生產之技術，如係運用臺灣母公司技術者，須支付臺灣母公司合理之報酬或權利金。</u></p> <p>(七) <u>申請人取得投資許可後，須向經濟部國際貿易局申請專案輸出許可，方可將其晶圓鑄造舊廠機器設備移至大陸地區。</u></p> <p>(八) <u>投資應對臺灣經濟發展有重大貢獻：增加臺灣母公司之營收或收益，或經由與大陸投資事業整合可大幅提升國內事業技術水準或運籌能力，採購臺灣設備及材料帶動相關產業之發展。</u></p> <p>(九) <u>投資應可取得全球市場之優勢地位，或可擴大全球市場之占有率。</u></p> <p>(十) <u>不得因大陸投資而有裁減臺灣員工之情形。</u></p>	<p>一、製造業未列禁止類之 8542320011、8542320013、8542320015、8542320021、8542320022、8542320031、8542320032、8542390011、8542390012 及 8542390021(八吋以下晶圓鑄造)等十項，其受理審查原則如下：</p> <p>(一) 投資案件審查採總量管制原則，以核准投資八吋廠三座為上限。</p> <p>(二) 個別廠商提出申請之條件，須在十二吋晶圓廠建廠完成且進入基本量產連續達六個月以上。</p> <p>(三) 機器設備移轉大陸時，必須十二吋晶圓廠達經濟規模之量產；將綜合景氣、成本、產值、良率等因素加以考量，並由關鍵技術小組作公正、客觀之判斷。</p> <p>(四) 已核准投資之三座八吋晶圓廠，其製程技術得依瓦聖納協議調整，並經關鍵技術小組審查。</p> <p>(五) 廠商執行投資計畫必須遵守相關法令規定。</p>	<p>一、現行備註第一點新設鑄造廠部分與現行備註第二點併購、參股投資部分，合併修正為備註第一點以使審查原則一致，並將原「八吋以下晶圓鑄造」修正為「不得為超過十二吋晶圓鑄造」。</p> <p>二、新設十二吋晶圓鑄造廠仍採總量管制，以三座為限，併購及參股投資則不受限制。</p> <p>三、依現行瓦聖納協議就製程世代屬四十五奈米以下者，須經專案許可，惟我國現行晶圓鑄造廠之製程技術已達十六奈米，而依修正第一點第二款規定，無論新設或併購、參股，其投資之製程技術須落後該公司在台灣製程技術一個世代以上，是以，我國赴大陸地區投資之晶圓鑄造公司製程技術遠高於瓦聖納協議，均須經由專案許可始得為之，故無須適用瓦聖納協議調整，爰刪除得依瓦聖納協議調整之規定。</p> <p>四、修正「晶圓製造」公司為「晶圓鑄造」公</p>

<p><u>(十一) 投資申請案將綜合景氣、成本、產值、良率等因素加以考量，並由關鍵技術小組作公正、客觀之判斷。</u></p> <p><u>(十二) 廠商執行投資計畫必須遵守相關法令規定。</u></p>		<p>司，以符合赴大陸地區投資晶圓鑄造廠之名稱。</p> <p>五、新增投資申請案將綜合景氣、成本、產值、良率等因素加以考量，由關鍵技術小組作公正、客觀之判斷。</p>
	<p>二、製造業未列禁止類之 8542320011、8542320013、8542320015、8542320021、8542320022、8542320031、8542320032、8542390011、8542390012 及 8542390021(併購、參股投資者)等十項，其受理審查原則如下：</p> <p>(一) 應為臺灣依公司法設立之公司。</p> <p>(二) 臺灣應有相對投資。</p> <p>(三) 併購、參股投資之製程技術須落後該公司在臺灣之製程技術一個世代以上。</p> <p>(四) 併購、參股投資之大陸晶圓鑄造廠生產之技術係運用臺灣母公司技術者，須支付臺灣母公司合理之報酬或權利金。</p> <p>(五) 投資應可取得全球市場之優勢地位，或可擴大全球市場之占有率。</p> <p>(六) 投資應對臺灣經濟發展有重大貢獻：增加臺灣母公司之營收或收益，或經由與大陸投資事業整合可大幅提升國內事業技術水準或運籌能力。</p> <p>(七) 不得因大陸投資而有裁減臺灣員工之情形。</p> <p>(八) 須經關鍵技術小組依併購或參股投資股權比重參照整體環境之景氣、成本投資效益等因素考量審議，並由關鍵技術小組作公正、客觀之判斷。</p> <p>(九) 廠商執行投資計畫必須遵守相關法令規定。</p>	<p><u>本點刪除。</u></p>

<p>二、投資半導體封裝、測試項目，個案投資金額超過五千萬美元者，須經關鍵技術小組參照景氣、成本、產值、良率等因素考量審議，並由關鍵技術小組作公正、客觀之判斷。</p>	<p>三、投資半導體封裝、測試項目，個案投資金額超過五千萬美元者，須經關鍵技術小組參照景氣、成本、產值、良率等因素考量審議，並由關鍵技術小組作公正、客觀之判斷。</p>	<p>點次變更。</p>
<p>三、製造業未列禁止類之 85312000、90138030(赴大陸投資設立之六代以上液晶顯示器面板廠，其技術應等同或落後國內該公司已設面板廠之最高世代)，其受理審查原則如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 應為臺灣從事 TFT-LCD 面板製造公司。 (二) 具主控權。 (三) 臺灣應有相對投資，提案申請者須於臺灣進行下世代面板廠之投資及研發，以維持我國面板產業之成長。 (四) 該公司在臺灣依據先前計畫投資新世代面板廠之進度，須列為關鍵技術小組審查之必要條件。 (五) 赴大陸投資之六代以上面板廠，以核准投資三座為上限；其技術應等同或落後臺灣該公司已設面板廠（已設面板廠：指建物完成且取得使用執照，設備裝機達可量產規模）之最高世代。 (六) 赴大陸投資生產之技術係運用臺灣母公司技術者，須支付臺灣母公司合理之報酬或權利金。 (七) 赴大陸投資可取得全球市場之優勢地位，或可擴大全球市場之占有率。 (八) 對臺灣經濟發展有重大貢獻：增加臺灣母公司之營收或收益，或經由與大陸投資事業整合可大幅提升國內事業技術水準或運籌能力。 (九) 促進臺灣設備、材料及其他相關產業（例如數位電視）之發展。 	<p>四、製造業未列禁止類之 85312000、90138030(赴大陸投資設立之六代以上液晶顯示器面板廠，其技術應等同或落後國內該公司已設面板廠之最高世代)，其受理審查原則如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 應為臺灣從事 TFT-LCD 面板製造公司。 (二) 具主控權。 (三) 臺灣應有相對投資，提案申請者須於臺灣進行下世代面板廠之投資及研發，以維持我國面板產業之成長。 (四) 該公司在臺灣依據先前計畫投資新世代面板廠之進度，須列為關鍵技術小組審查之必要條件。 (五) 赴大陸投資之六代以上面板廠，以核准投資三座為上限；其技術應等同或落後臺灣該公司已設面板廠（已設面板廠：指建物完成且取得使用執照，設備裝機達可量產規模）之最高世代。 (六) 赴大陸投資生產之技術係運用臺灣母公司技術者，須支付臺灣母公司合理之報酬或權利金。 (七) 赴大陸投資可取得全球市場之優勢地位，或可擴大全球市場之占有率。 (八) 對臺灣經濟發展有重大貢獻：增加臺灣母公司之營收或收益，或經由與大陸投資事業整合可大幅提升國內事業技術水準或運籌能力。 (九) 促進臺灣設備、材料及其他相關產業（例如數位電視）之發展。 	<p>點次變更。</p>

<p>(十) 不得因大陸投資而有裁減臺灣員工之情形。</p> <p>(十一) 須經關鍵技術小組參照景氣、成本、產值、良率等因素考量審議，並由關鍵技術小組作公正、客觀之判斷。</p> <p>(十二) 廠商執行投資計畫必須遵守相關法令規定。</p>	<p>(十) 不得因大陸投資而有裁減臺灣員工之情形。</p> <p>(十一) 須經關鍵技術小組參照景氣、成本、產值、良率等因素考量審議，並由關鍵技術小組作公正、客觀之判斷。</p> <p>(十二) 廠商執行投資計畫必須遵守相關法令規定。</p>	
<p>四、製造業未列禁止類之 85312000、90138030(併購或參股投資液晶顯示器面板廠)，其受理審查原則如下：</p> <p>(一) 應為臺灣依公司法設立之公司。</p> <p>(二) 臺灣應有相對投資。</p> <p>(三) 併購、參股投資之製程技術，須納入關鍵技術小組進行細部審查。</p> <p>(四) 赴大陸投資生產之技術係運用臺灣母公司技術者，須支付臺灣母公司合理之報酬或權利金。</p> <p>(五) 赴大陸投資可取得全球市場之優勢地位，或可擴大全球市場之占有率。</p> <p>(六) 對臺灣經濟發展有重大貢獻：增加臺灣母公司之營收或收益，或經由與大陸投資事業整合可大幅提升國內事業技術水準或運籌能力。</p> <p>(七) 不得因大陸投資而有裁減臺灣員工之情形。</p> <p>(八) 須經關鍵技術小組參照景氣、成本、產值、良率等因素考量審議，並由關鍵技術小組作公正、客觀之判斷。</p> <p>(九) 廠商執行投資計畫必須遵守相關法令規定。</p>	<p>五、製造業未列禁止類之 85312000、90138030(併購或參股投資液晶顯示器面板廠)，其受理審查原則如下：</p> <p>(一) 應為臺灣依公司法設立之公司。</p> <p>(二) 臺灣應有相對投資。</p> <p>(三) 併購、參股投資之製程技術，須納入關鍵技術小組進行細部審查。</p> <p>(四) 赴大陸投資生產之技術係運用臺灣母公司技術者，須支付臺灣母公司合理之報酬或權利金。</p> <p>(五) 赴大陸投資可取得全球市場之優勢地位，或可擴大全球市場之占有率。</p> <p>(六) 對臺灣經濟發展有重大貢獻：增加臺灣母公司之營收或收益，或經由與大陸投資事業整合可大幅提升國內事業技術水準或運籌能力。</p> <p>(七) 不得因大陸投資而有裁減臺灣員工之情形。</p> <p>(八) 須經關鍵技術小組參照景氣、成本、產值、良率等因素考量審議，並由關鍵技術小組作公正、客觀之判斷。</p> <p>(九) 廠商執行投資計畫必須遵守相關法令規定。</p>	<p>點次變更。</p>

<p>五、開放赴大陸地區投資項目 27111400、29012100、29012200、29012410、29022000、29024100 及 29024300(赴大陸地區投資設立、併購或參股石化公司)，其受理審查原則如下：</p> <p>(一) 審查從事乙烯等七項產品之投資案，各企業及其關係企業以參與一件投資案審查為原則，未來視發展情勢再行檢討。</p> <p>(二) 申請人應為依臺灣公司法設立之公司，並以生產石化品為主要業務，赴大陸地區投(增)資有助於帶動國內相關產業競爭力、提升企業全球運籌管理能力。</p> <p>(三) 申請人對該投(增)資事業取得超過百分之五十股權，或取得特定產品項目之經營主導權。</p> <p>(四) 投(增)資案件審查採穩定國內發展為原則，不得因赴大陸地區投(增)資而有停工、停產、減產或裁員等影響國內石化產業穩定發展之情形。</p> <p>(五) 投(增)資公司須提出在國內高值化石化品之相對投資，其規模不得低於申請投(增)資金額。</p> <p>(六) 投(增)資公司需配合行政院核定之石化產業高值化推動方案，規劃國內事業研發投入及高值化投資相關事宜。</p> <p>(七) 投(增)資公司應規劃上述產品部分優先供應國內需求及回運國內之儲運系統。</p> <p>(八) 投(增)資應對國內經濟發展有重大貢獻：增加母公司之營收或收益，帶動高值化石化產品發展，或經由與大陸地區投資事業整合可大幅提升國內事業技術水準或運籌能力。</p> <p>(九) 赴大陸地區投(增)資案件對國家安全無嚴重之不利影響。</p> <p>(十) 廠商執行投資計畫必須遵守相關法令規定。</p>	<p>六、開放赴大陸地區投資項目 27111400、29012100、29012200、29012410、29022000 29024100 及 29024300(赴大陸地區投資設立、併購或參股石化公司)，其受理審查原則如下：</p> <p>(一) 審查從事乙烯等七項產品之投資案，各企業及其關係企業以參與一件投資案審查為原則，未來視發展情勢再行檢討。</p> <p>(二) 申請人應為依臺灣公司法設立之公司，並以生產石化品為主要業務，赴大陸地區投(增)資有助於帶動國內相關產業競爭力、提升企業全球運籌管理能力。</p> <p>(三) 申請人對該投(增)資事業取得超過百分之五十股權，或取得特定產品項目之經營主導權。</p> <p>(四) 投(增)資案件審查採穩定國內發展為原則，不得因赴大陸地區投(增)資而有停工、停產、減產或裁員等影響國內石化產業穩定發展之情形。</p> <p>(五) 投(增)資公司須提出在國內高值化石化品之相對投資，其規模不得低於申請投(增)資金額。</p> <p>(六) 投(增)資公司需配合行政院核定之石化產業高值化推動方案，規劃國內事業研發投入及高值化投資相關事宜。</p> <p>(七) 投(增)資公司應規劃上述產品部分優先供應國內需求及回運國內之儲運系統。</p> <p>(八) 投(增)資應對國內經濟發展有重大貢獻：增加母公司之營收或收益，帶動高值化石化產品發展，或經由與大陸地區投資事業整合可大幅提升國內事業技術水準或運籌能力。</p> <p>(九) 赴大陸地區投(增)資案件對國家安全無嚴重之不利影響。</p> <p>(十) 廠商執行投資計畫必須遵守相關法令規定。</p>	<p>點次變更。</p>
--	--	--------------

